# 基于第一性原理研究 H<sub>2</sub>O 分子在双相 TiAl 合金表面 的吸附行为

doi:10.3969/j.issn.1674-7100.2023.05.001

肖 鹏 王 鑫 唐 卿 刘伦峰 李文元 廖翠姣

湖南工业大学 机械工程学院 湖南 株洲 412007 摘 要: 为研究电场作用对  $H_2O$  分子在  $\gamma$ -TiAl 和  $\alpha_2$ -Ti<sub>3</sub>Al 表面的吸附行为影响,采用第一性原理方法对  $H_2O$  分子在  $\gamma$ -TiAl (111) 和  $\alpha_2$ -Ti<sub>3</sub>Al (0001) 表面不同吸附位置的吸附能、态密度、几何结构、电荷布局进行分析。结果发现, $H_2O$  分子在  $\gamma$ -TiAl (111) 和  $\alpha_2$ -Ti<sub>3</sub>Al (0001) 表面上的 top Ti 位置吸附最为稳定,但电场更容易促进  $H_2O$  分子与  $\alpha_2$ -Ti<sub>3</sub>Al (0001) 表面的相互作用,即  $\alpha_2$ -Ti<sub>3</sub>Al 更易与  $H_2O$  分子发生反应,从而优先形成 Ti 的致密氧化膜,致使  $\alpha_2$ -Ti<sub>3</sub>Al 被保护。探究  $\gamma$ -TiAl 和  $\alpha_2$ -Ti<sub>3</sub>Al 单相具有相同溶解速度的条件,对提升双相( $\gamma$ -TiAl 和  $\alpha_2$ -Ti<sub>3</sub>Al 相) TiAl 合金电解加工表面质量具有十分重要的意义。

关键词:第一性原理;  $H_2O$  分子; 吸附行为;  $\gamma$ -TiAl 合金;  $\alpha_2$ -Ti $_3$ Al 合金

中图分类号: O641 文献标志码: A

文章编号: 1674-7100(2023)05-0001-07

引文格式: 肖 鵬, 王 鑫, 唐 卿, 等. 基于第一性原理研究  $H_2O$  分子在 双相 TiAl 合金表面的吸附行为 [J]. 包装学报, 2023, 15(5): 1-7.

# 1 研究背景

当水系电解液与金属界面接触时,电荷会在金属表面重新分布,在金属/电解液界面处会形成双电层。双电层是电化学反应过程中物质和能量交换的场所。而溶液中的 H<sub>2</sub>O 分子在金属表面的吸附行为及双电层结构对电化学溶解机理也有着重要影响<sup>[1]</sup>。研究人员通常利用实验探究 H<sub>2</sub>O 分子在金属表面的吸附行为对双电层结构的影响<sup>[2-4]</sup>,然而,实验很难直接获得电子结构信息及 H<sub>2</sub>O 分子与基底相互作用中的电子转移等微观信息。计算模拟技术则可以解决该类问

题 [5-12]

第一性原理(first principles)又称为从头计算,是仅依据晶体结构、原子坐标等结构参数,基于密度泛函理论(density functional theory,DFT)求解相关电子的波函数并进行分析的方法  $^{[13]}$ 。Zhu S. L. 等  $^{[14]}$ 使用密度泛函理论研究了  $H_2O$  分子在  $\gamma$ -U(110)表面的吸附行为,结果发现, $H_2O$  分子倾向于在顶部位点发生平行吸附,表面铀的 6d 轨道和氧的 2p 轨道之间的杂化起主导作用。陈荐等  $^{[15]}$  对  $H_2O$  在 Cu(111)表面的吸附和解离进行了研究,结果发现, $H_2O$  以分子形态稳定吸附在 Cu(111)表面的顶部位点(top

收稿日期: 2023-05-10

基金项目: 国家自然科学基金资助项目(22072040);湖南省自然科学基金资助项目(2023JJ50163) 作者简介: 肖 鹏(1998-),男,河南南阳人,湖南工业大学硕士生,主要研究方向为电解加工仿真,

E-mail: 1398332273@qq.com

通信作者:廖翠姣(1977-),女,湖南新化人,湖南工业大学副教授,博士,主要从事精密电解加工机理及工艺优化研究,

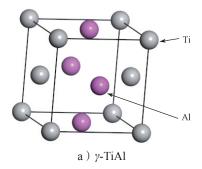
E-mail: xiaocuijiao@163.com

位),主要是 O 2p 态与 Cu 3d 态有较强的杂化作用。 L. Bellarosa 等  $^{[16]}$  采用第一性原理分子动力学研究了 Pd、Pt 和 Ru 上薄水膜的性质,发现水与 Pd 和 Pt 之间的界面处,存在五元环和七元环的结构模式,导致靠近表面的水界面层致密化。厦门大学的李剑锋团队研究了 Pd 单晶表面上的界面水,发现由于偏置电位的存在,界面水结构发生由随机分布到有序结构的动态变化,促进了界面上的电子高效转移  $^{[17]}$ 。由此可见, $H_2O$  分子在金属表面的吸附行为对金属表面的电子转移以及电化学反应的过程起着不可忽视的作用。

目前,尚未见到  $H_2O$  分子在 TiAl 表面的吸附行为或机理的相关报道,而  $H_2O$  分子在 TiAl 合金表面的吸附行为是探索 TiAl 合金电化学溶解机理的重要基础。由于  $\gamma$ -TiAl 沿着(111) 密排面连续形核生长  $^{[18]}$ , 其在双相 TiAl 合金中与  $\alpha_2$ - $Ti_3Al$  (0001) 表面形成界面,且(0001) 表面在  $\alpha_2$ - $Ti_3Al$  中最稳定  $^{[19]}$ ,因此,研究  $\gamma$ -TiAl (111) 表面和  $\alpha_2$ - $Ti_3Al$  (0001) 表面更为合适。基于此,本研究采用第一性原理研究  $H_2O$  分子在  $\gamma$ -TiAl (111) 表面和  $\alpha_2$ - $Ti_3Al$  (0001) 表面上的吸附行为,并探索电场对  $H_2O$  分子吸附行为的影响,为探寻双相( $\gamma$ -TiAl 相和  $\alpha_2$ - $Ti_3Al$  相) TiAl 合金均匀溶解机理提供分子水平的理论支撑。

# 2 理论方法与模型

首先,本研究需要构建  $H_2O$  分子在  $\gamma$ -TiAl(111)表面和  $\alpha_2$ -Ti $_3$ Al(0001)表面上的模型。 $\gamma$ -TiAl 和  $\alpha_2$ -Ti $_3$ Al的晶格结构如图 1 所示  $^{[20]}$ 。图 1a 中, $\gamma$ -TiAl为  $L1_0$ 结构,面心立方结构,单胞结构中有 2 个 Ti 原子和 2 个 Al 原子,晶格常数: $\alpha=\beta=\gamma=90^\circ$ ,a=b=4.02Å,c=4.07Å,为 P4/mmm 空间群结构。图 1b 中, $\alpha_2$ -Ti $_3$ Al为 D0 $_1$ 9点阵结构,单胞中有 6 个 Ti 原子,2个 Al 原子,晶格常数: $\alpha=\beta=90^\circ$ , $\gamma=120^\circ$ ,a=b=5.76Å,c=4.66Å,为 P6 $_3$ /mmc 空间群结构。



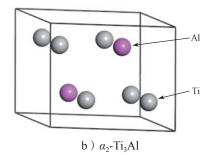


图 1 TiAl 合金晶体结构模型

Fig. 1 Crystal structure model of TiAl alloy

在此基础上,再使用DFT的广义梯度近似方法 [21] (GGA-PBE) 对  $\gamma$ -TiAl 单晶、 $\alpha_2$ -Ti $_3$ Al 以及  $H_2$ O 分子进行优化计算。优化  $\gamma$ -TiAl 单晶的参数设置截断能为 400.00 eV,K 点密度为 6×6×6,赝势为 OTFG ultra 超软赝势,当迭代的最后两次的总能量差达到 5.0×10<sup>-6</sup> eV/atom、原子应力偏差达到 0.02 GPa、最大位移为 0.002 Å 时,认为计算结果已收敛;采用相同方式优化  $\alpha_2$ -Ti $_3$ Al 和  $H_2$ O 分子。优化后, $\gamma$ -TiAl 的晶体参数为 a=b=3.99 Å,c=4.08 Å; $\alpha_2$ -Ti $_3$ Al 的为 a=b=5.755 Å,c=4.654 Å; $H_2$ O 分子的 O—H 键长键角分别为 0.985 Å 和 103.217°。三者优化结构与实验测量值基本保持一致,表明该优化参数可行 [20,22]。

考虑到周期性结构对 TiAl 合金溶解体系可能造成的影响  $^{[23]}$ , 在  $\gamma$ -TiAl 合金(111)表面的 Z 方向添加 10 Å 的真空层,建立 6 层原子结构模型  $^{[24]}$ (见图 2a),其中,上面三层定义为表面区,下面三层定义为体相区。采用同样方法构建  $\alpha_2$ - $Ti_3$ Al(0001)表面区和体相区结构模型(见图 2b)。

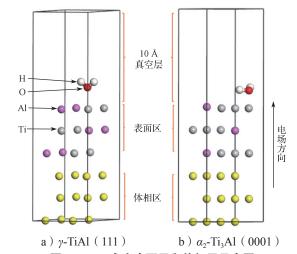


图 2 TiAl 合金表面区和体相区示意图

Fig. 2 Diagram of surface region and bulk phase region of TiAl alloy

#### 基于第一性原理研究 H<sub>2</sub>O 分子在双相 TiAI 合金表面的吸附行为

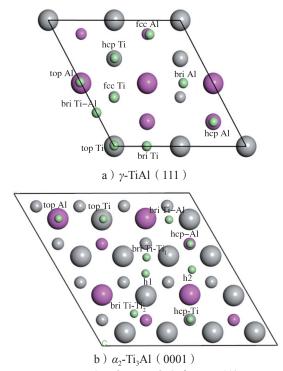


图 3 H<sub>2</sub>O 分子在 TiAl 合金表面吸附位置图 Fig. 3 Adsorption position of H<sub>2</sub>O molecules on the surface of TiAl alloy

# 3 计算结果与讨论

### 3.1 H<sub>2</sub>O 分子在 TiAl 合金表面的吸附行为

#### 3.1.1 吸附能

将  $H_2O$  分子分别放在  $\gamma$ -TiAl(111)和  $\alpha_2$ -Ti<sub>3</sub>Al(0001)表面上的 9 个吸附点的正上方 2.5 Å 处进行结构优化。 $H_2O$  分子分别在  $\gamma$ -TiAl 表面和  $\alpha_2$ -Ti<sub>3</sub>Al 表面的吸附能的计算公式分别为式(1)和式(2)<sup>[25]</sup>。

$$E = E_{\gamma - \text{TiAl(111) H}_{2}O} - E_{\gamma - \text{TiAl(111)}} - E_{\text{H}_{2}O}, \qquad (1)$$

$$E = E_{_{\alpha_2}\text{-Ti}_3\text{Al}(0001)\text{ H}_2\text{O}} - E_{_{\alpha_2}\text{-Ti}_3\text{Al}(0001)} \ - E_{\text{H}_2\text{O}\,\circ} \quad \ (\ 2\ )$$

其中:  $E_{\gamma\text{-TiAl(111)} H_2O}$  和 $E_{\alpha_2\text{-Ti}_3Al(0001) H_2O}$  表示  $H_2O$  分子分别与  $\gamma\text{-TiAl}$  和  $\alpha_2\text{-Ti}_3Al$  的吸附总能量, $E_{H_2O}$  表示单个  $H_2O$  分子的总能量, $E_{\gamma\text{-TiAl(111)}}$  和 $E_{\alpha_2\text{-Ti}_3Al(0001)}$ 分别表示  $\gamma\text{-TiAl(111)}$  和  $\alpha_2\text{-Ti}_3Al(0001)$ 表面的总能量。

 $H_2O$  分子在  $\gamma$ -TiAl 表面上的 9 个吸附位点优化后,发现仅在 top Ti 和 top Al 位点的位置不变,其它位点均将移动到 top Ti 位点。由此说明, $H_2O$  分子在其他 7 个位点均存在不稳定吸附。因此,后续研究仅分析  $\gamma$ -TiAl 表面的 top Ti 和 top Al 位点吸附能。同样, $H_2O$  分子在  $\alpha_2$ -Ti<sub>3</sub>Al 表面的 9 个吸附位置中仅在top Ti 和 bri Ti<sub>2</sub> 发生稳定吸附(如图 4 所示),在其他位点均存在不稳定吸附。

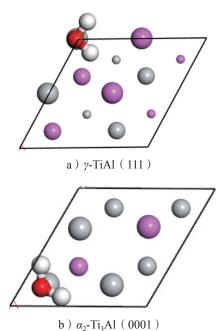


图 4 H<sub>2</sub>O 分子稳定吸附在 TiAl 表面俯视图 Fig. 4 Top view of H<sub>2</sub>O molecules stably adsorbed on TiAl surface

根据式(1)、(2)计算得到  $H_2O$  分子分别在  $\gamma$ -TiAl(111)和  $\alpha_2$ -Ti<sub>3</sub>Al(0001)表面上的 2 个稳定 位点的吸附能如表 1 所示。 $H_2O$  分子在  $\gamma$ -TiAl(111)表面上的 top Ti 和 top Al 位点的吸附能分别为 -0.675 eV 和 -0.090 eV。由此说明,top Ti 位置为  $H_2O$  分子在  $\gamma$ -TiAl(111)表面的最稳定吸附位点。 $H_2O$  分子在  $\gamma$ -TiAl(111)表面的最稳定吸附位点。 $H_2O$  分子在  $\alpha_2$ -Ti<sub>3</sub>Al(0001)表面上的 top Ti 和 bri Ti<sub>2</sub> 位点的 吸附能分别为 -2.214 eV 和 -2.171 eV。由此说明, $H_2O$  分子在  $\alpha_2$ -Ti<sub>3</sub>Al(0001)表面的 top Ti 位置更稳定。进而说明, $H_2O$  分子在双相 TiAl 合金表面优先与  $\alpha_2$ -Ti<sub>3</sub>Al 相发生吸附,然后与  $\gamma$ -TiAl 发生吸附。

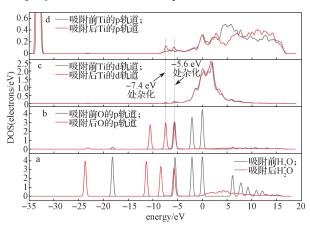
表 1 H<sub>2</sub>O 分子在 γ-TiAl (111) 和 α<sub>2</sub>-Ti<sub>3</sub>Al (0001) 表面的吸附能

金属表面	初始吸附位点	吸附能 /eV	优化后位置
γ-TiAl (111)	top Ti	-0.675	不变
	top Al	-0.090	不变
α <sub>2</sub> -Ti <sub>3</sub> Al( 0001 )	top Ti	-2.214	不变
	bri Ti <sub>2</sub>	-2.171	不变

注:吸附能为正,为吸热反应;吸附能为负,为放热反应。

#### 3.1.2 态密度

态密度是固体自由表面的电子能级和电子态分布特征,表示单位能量范围内( $E\sim E+\Delta E$ )的电子数目 [26]。图 5~6 分别是  $H_2O$  分子吸附在  $\gamma$ -TiAl(111)和  $\alpha_2$ -Ti,Al(0001)表面前后 top Ti 位置处的态密度图。



**图 5** H<sub>2</sub>O 分子吸附在 γ-TiAl (111) 表面 top Ti 位置的前后分态密度

Fig. 5 The front and back fractal density of H<sub>2</sub>O adsorbed at the top Ti position on γ-TiAl (111) surface

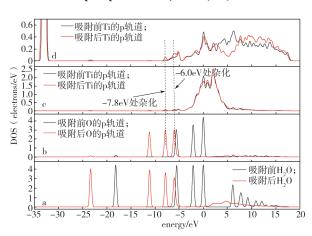


图 6  $H_2O$  分子吸附在  $\alpha_2$ - $Ti_3Al$  (0001) 表面 top Ti 位置的前后分态密度

Fig. 6 The front and back fractal density of  $H_2O$  adsorbed at the top Ti position on  $\alpha_2$ -Ti<sub>3</sub>Al (0001) surface

由图 5a、图 6a 可知, $H_2O$  分子吸附在  $\gamma$ -TiAl(111)和  $\alpha_2$ -Ti<sub>3</sub>Al(0001)表面后,水的总态密度曲线均整体向低能量区移动、且峰值降低,即吸附后  $H_2O$  分子的能量降低,结构更加稳定,这与上述的负吸附能相吻合  $^{[27]}$ 。 $H_2O$  分子吸附在  $\gamma$ -TiAl(111)表面时,分子中O的p轨道与 Ti 的p、d轨道分别在 -7.4,-5.6 eV 处有一定重叠(见图 5b~d),由此表明,O的p轨道与 Ti 的p、d轨道分别存在一定的杂化作用。 $H_2O$  分子吸附在  $\alpha_2$ -Ti<sub>3</sub>Al(0001)表面, $H_2O$  分子中O的p轨道与 Ti 元素的 p、d轨道也分别在 -7.8,-6.0 eV 处有一定重叠(图 6b~d)。由此表明, $H_2O$  分子与双相 TiAl 表面的吸附作用主要是 O 的 p 轨道 分别与 Ti 元素的 p、d 轨道杂化引起的  $^{[28]}$ 。

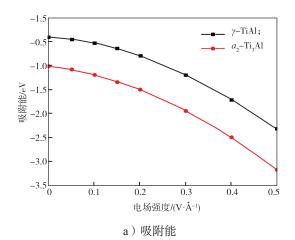
#### 3.2 电场对吸附行为的影响

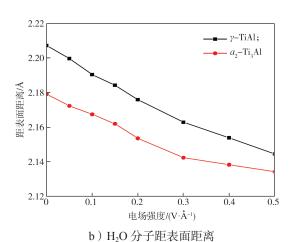
为了分析电场对双相 TiAl 合金中  $\gamma$ -TiAl(111)以及  $\alpha_2$ -Ti<sub>3</sub>Al(0001)表面吸附行为的影响,分别在  $H_2O$  分子与  $\gamma$ -TiAl(111)及  $\alpha_2$ -Ti<sub>3</sub>Al(0001)表面建立的吸附体系上,添加平行于 Z方向的电场  $^{[29]}$ (0.1~0.5 V/Å,见图 2)。添加电场后  $H_2O$  分子分别与  $\gamma$ -TiAl(111)及  $\alpha_2$ -Ti<sub>3</sub>Al(0001)表面的吸附能、表面距离、键布居数、电子转移及生成的角度等吸附行为参数信息如图 7 所示。

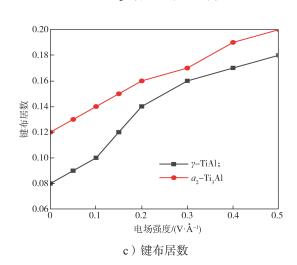
由图 7a 可知,随着电场增强,H<sub>O</sub> 分子分别与  $\gamma$ -TiAl(111)和  $\alpha_2$ -Ti<sub>3</sub>Al(0001)表面之间的吸附能 几乎平行下降,趋于负值,说明添加电场后体系均 发生放热反应,且越来越剧烈。由图 7b 可知,随着 电场增强, H<sub>2</sub>O 分子与两表面的距离越来越小, 两曲 线逐渐靠近,说明添加电场后 H<sub>2</sub>O 分子与 TiAl 合金 发生吸附作用越强, 并减小了 H,O 分子与两相反应 的差异。由图 7c 可知,随着电场增强,H2O 分子分 别与 γ-TiAl (111) 和  $\alpha_2$ -Ti<sub>3</sub>Al (0001) 表面的键布居 数以较快速度上升,表明 H,O 分子中的 O 和 TiAl 合 金中的 Ti 元素的共价键越来越强。但随着电场增强,  $H_2O$  分子中的 O 与  $\alpha_2$ - $Ti_3Al$  中的 Ti 共价键强度大于 H<sub>2</sub>O 分子中的 O 与 γ-TiAl 中的 Ti 的共价键,表明在 电场作用下, H<sub>2</sub>O 分子与 α<sub>2</sub>-Ti<sub>3</sub>Al 相互作用更强, 在 开路状态下 H<sub>2</sub>O 分子与 α<sub>2</sub>-Ti<sub>3</sub>Al 相更容易生成氧化 物,发生钝化。由图 7d 可知,随着电场增强, H<sub>2</sub>O 分子中电荷数逐渐增加,说明此时 H2O 分子失去电 子越来越多,转移到 TiAl 合金表面的电子也越来越 多;且随着电场增强, $H_2O$ 分子中的电子转移到 $\alpha_2$ -Ti<sub>3</sub>Al(0001)表面的更多,再一次说明, H<sub>2</sub>O分子

#### 基于第一性原理研究 H<sub>2</sub>0 分子在双相 TiAI 合金表面的吸附行为

与  $\alpha_2$ -Ti<sub>3</sub>Al 相的吸附反应更强。由图 7e 可知,随着电场增强, $H_2O$ 分子与 TiAl合金表面形成的夹角增大,最后稳定在 90°。在夹角达到 90°之前, $H_2O$  分子与  $\alpha_2$ -Ti<sub>3</sub>Al(0001)表面形成的夹角总是大于  $H_2O$  分子与  $\gamma$ -TiAl(111)表面形成的夹角,再次说明  $H_2O$  分子与  $\alpha_2$ -Ti<sub>3</sub>Al 的吸附反应更强。







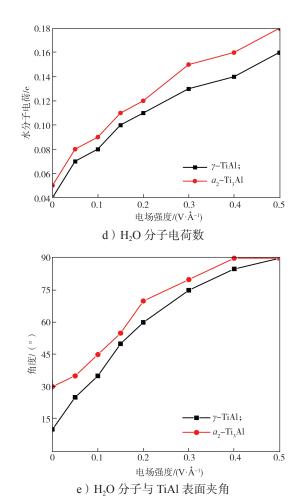


图 7 H<sub>2</sub>O 分子在 γ-TiAl (111) 和 α<sub>2</sub>-Ti<sub>3</sub>Al (0001) 表面 吸附行为参数随电场强度的变化曲线

Fig. 7 The adsorption behavior of  $H_2O$  molecules on  $\gamma$ -TiAl (111) and  $\alpha_2$ -Ti<sub>3</sub>Al (0001) surfaces varying with the electric field intensity

为了验证上述计算结果的准确性,在由 SAS SP-150/20A 型电化学工作站和三电极(裸露面积约 0.25 cm² 的合金为工作电极;4 cm² 的 Pt 片为对电极;饱和甘汞电极为参比电极)组成的电化学测试系统平台做线性极化曲线,电压扫描区间为开路电位 ~4 V,扫描速率为 20 mV/s<sup>[30]</sup>。此处工作电极为 Ti-50Al-2Cr-2Nb 和 Ti-30Al-2Cr-2Nb 合金,分别代替单相 $\gamma$ -TiAl 合金和单相  $\alpha_2$ -Ti<sub>3</sub>Al 合金,测试结果如图 8 所示。

由图 8 可知,单相  $\alpha_2$ -Ti<sub>3</sub>Al 合金的开路电位和钝化电位均比单相  $\gamma$ -TiAl 合金的高,说明  $\alpha_2$ -Ti<sub>3</sub>Al 合金更容易生成氧化物发生钝化。由于钝化膜的机械阻隔作用, $\alpha_2$ -Ti<sub>3</sub>Al 合金的电流密度比单相  $\gamma$ -TiAl 合金的低,直到两者均达到钝化,电流密度趋于相等;随着

电位的进一步增加, $\gamma$ -TiAl 合金的电流密度又再次超过  $\alpha_2$ -Ti<sub>3</sub>Al 合金的电流密度。极化曲线揭示的结果与第一性原理计算的结果完全吻合,证明了计算结果的可靠性。

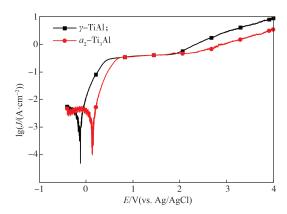


图 8 单相 γ-TiAl 合金和单相 α<sub>2</sub>-Ti<sub>3</sub>Al 合金的 阳极极化曲线

Fig. 8 Anodic polarization curves of single-phase γ-TiAl alloy and single-phase α<sub>2</sub>-Ti<sub>3</sub>Al alloy

## 4 结论

本文通过第一性原理探究  $H_2O$  分子与双相 TiAl 合金中的  $\gamma$ -TiAl 和  $\alpha_2$ -Ti $_3$ Al 相的吸附行为及电场对吸附行为的影响,并采用电化学测试验证计算结果的准确性,得出以下主要结论:

- 1) $H_2O$  分子在  $\alpha_2$ - $Ti_3Al$ (0001)表面上的 top Ti 位点发生稳定吸附,由  $H_2O$  分子中 O 的 p 轨道和 Ti 中的 p、d 轨道杂化引起吸附行为;
- 2)电场改变了  $H_2O$  分子与  $\gamma$ -TiAl 和  $\alpha_2$ -Ti<sub>3</sub>Al 双相 TiAl 合金的吸附强度、表面距离、mulliken 键布居数、电荷数及吸附角度, $H_2O$  分子与  $\alpha_2$ -Ti<sub>3</sub>Al 相更容易生成稳定的 O—Ti 共价键;
- 3)单相  $\gamma$ -TiAl 和单相  $\alpha_2$ -Ti<sub>3</sub>Al 合金的极化曲线 证实在相同电解液中  $\alpha_2$ -Ti<sub>3</sub>Al 相更容易发生氧化生成 钝化膜。

#### 参考文献:

- [1] SHIN S J, KIM D H, BAE G, et al. On the Importance of the Electric Double Layer Structure in Aqueous Electrocatalysis[J]. Nature Communications, 2022, 13: 174.
- [2] LE JB, CHENG J. Modeling Electrochemical Interfaces

- from Ab Initio Molecular Dynamics: Water Adsorption on Metal Surfaces at Potential of Zero Charge[J]. Current Opinion in Electrochemistry, 2020, 19: 129–136.
- [3] LE J B, CHENG J. Modeling Electrified Metal/Water Interfaces from Ab Initio Molecular Dynamics: Structure and Helmholtz Capacitance[J]. Current Opinion in Electrochemistry, 2021, 27: 100693.
- [4] LE J B, FAN Q Y, LI J Q, et al. Molecular Origin of Negative Component of Helmholtz Capacitance at Electrified Pt(111)/Water Interface[J]. Science Advances, 2020, 6(41): 1219.
- [5] RUIZ-LOPEZ M F, FRANCISCO J S, MARTINS-COSTA M T C, et al. Molecular Reactions at Aqueous Interfaces[J]. Nature Reviews Chemistry, 2020, 4(9): 459–475.
- [6] BOUZID A, PASQUARELLO A. Atomic-Scale Modelling of Electrochemical Interfaces Through Constant Fermi Level Molecular Dynamics[J]. Atomic-Scale Modelling of Electrochemical Systems, 2021; 221–240.
- [7] MELANDER M M, LAURILA T T, LAASONEN K. Atomic-Scale Modelling of Electrochemical Systems[M]//LE J B, YANG X H, ZHUANG Y B, et al. Ab Initio Modeling of Electrochemical Interfaces and Determination of Electrode Potentials. Hoboken: John Wiley & Sons, Inc., 2021: 173–200.
- [8] XING HR, HUP, LISL, et al. Adsorption and Diffusion of Oxygen on Metal Surfaces Studied by First-Principle Study: A Review[J]. Journal of Materials Science & Technology, 2021, 62: 180–194.
- [9] BURASCHI M, SANSOTTA S, ZAHN D. Polarization Effects in Dynamic Interfaces of Platinum Electrodes and Ionic Liquid Phases: A Molecular Dynamics Study[J]. The Journal of Physical Chemistry C, 2020, 124(3): 2002–2007.
- [10] KNIJFF L, JIA M, ZHANG C. Electric Double Layer at the Metal-Oxide/Electrolyte Interface[M]//Encyclopedia of Solid-Liquid Interfaces. Amsterdam: Elsevier, 2024: 567-575.
- [11] LI J Q, SUN Y, CHENG J. Theoretical Investigation on Water Adsorption Conformations at Aqueous Anatase TiO<sub>2</sub>/Water Interfaces[J]. Journal of Materials Chemistry A, 2023, 11(2): 943–952.
- [12] LI L, LIU Y P, LE J B, et al. Unraveling Molecular Structures and Ion Effects of Electric Double Layers at Metal Water Interfaces[J]. Cell Reports Physical Science, 2022, 3(2): 100759.
- [13] JIAN Y X, HUANG Z F, XING J D, et al. Phase Stability, Mechanical Properties and Electronic

# 

- Structures of TiAl Binary Compounds by First Principles Calculations[J]. Materials Chemistry and Physics, 2019, 221: 311-321.
- [14] ZHU S L, YANG Y X, ZHANG Z F, et al. Density Functional Theory Study of Adsorption of H<sub>2</sub>O on γ-U(110) Surface[J]. Indian Journal of Physics, 2023, 97(8): 2297-2306.
- [15] 陈 荐, 李 超, 任延杰, 等. H,O 在 Cu(111) 表面 吸附和解离的第一性原理[J]. 长沙理工大学学报(自 然科学版), 2017, 14(2): 92-97. CHEN Jian, LI Chao, REN Yanjie, et al. First-Principles Study of Adsorption and Dissociation of H<sub>2</sub>O on Cu(111) Surface[J]. Journal of Changsha University of Science & Technology (Natural Science), 2017, 14(2): 92-97.
- [16] BELLAROSA L, GARCÍA-MUELAS R, REVILLA-LÓPEZ G, et al. Diversity at the Water-Metal Interface: Metal, Water Thickness, and Confinement Effects[J]. ACS Central Science, 2016, 2(2): 109-116.
- [17] WANG Y H, ZHENG S S, YANG W M, et al. In Situ Raman Spectroscopy Reveals the Structure and Dissociation of Interfacial Water[J]. Nature, 2021, 600(7887): 81-85.
- [18] DEY S R, BOUZY E, HAZOTTE A. Intragranular Nucleation Sites of Massive y Grains in a TiAl-Based Alloy[J]. Scripta Materialia, 2007, 57(4): 365-368.
- [19] KOIZUMI Y, SUGIHARA A, TSUCHIYA H, et al. Selective Dissolution of Nanolamellar Ti-41 At.% Al Alloy Single Crystals[J]. Acta Materialia, 2010, 58(8): 2876-2886.
- [20] WEI Y, ZHANG Y, LU G H, et al. Effects of Transition Metals in a Binary-Phase TiAl-Ti<sub>3</sub>Al Alloy: From Site Occupancy, Interfacial Energetics to Mechanical Properties[J]. Intermetallics, 2012, 31: 105-113.
- [21] PERDEW J P, CHEVARY J A, VOSKO S H, et al. Atoms, Molecules, Solids, and Surfaces: Applications of the Generalized Gradient Approximation for Exchange and Correlation[J]. Physical Review B, 1992, 46(11): 6671-6687.
- [22] SANTRAB, MICHAELIDESA, FUCHSM, et al. On the Accuracy of Density-Functional Theory Exchange-Correlation Functionals for H Bonds in Small Water Clusters. II. the Water Hexamer and van Der Waals Interactions[J]. The Journal of Chemical Physics, 2008, 129(19): 194111.
- [23] ZGHAL S, NAKA S, COURET A. A Quantitative Tem Analysis of the Lamellar Microstructure in TiAl Based Alloys[J]. Acta Materialia, 1997, 45(7): 3005-3015.

- [24] SONG Y, DAI J H, YANG R. Mechanism of Oxygen Adsorption on Surfaces of  $\gamma$ -TiAl[J]. Surface Science, 2012, 606(9/10): 852-857.
- [25] 赵 巍, 汪家道, 刘峰斌, 等. H,O 分子在 Fe(100), Fe(110), Fe(111) 表面吸附的第一性原理研究 [J]. 物理 学报, 2009, 58(5): 3352-3358. ZHAO Wei, WANG Jiadao, LIU Fengbin, et al. First Principles Study of H<sub>2</sub>O Molecule Adsorption on Fe(100), Fe(110) and Fe(111) Surfaces[J]. Acta Physica Sinica, 2009, 58(5): 3352-3358.
- [26] 冯 晶,肖 冰,陈敬超,等 . 第一原理计算  $\alpha$ -Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 电子态密度性质分析[J]. 昆明理工大学学报(理工版), 2006, 31(4): 18-22. FENG Jing, XIAO Bing, CHEN Jingchao, et al. Research on Band Structure and DOS of Sapphire by "ab-Initial" Methods Based on DFT[J]. Journal of Kunming University of Science and Technology (Science and Technology), 2006, 31(4): 18-22.
- [27] 秦 娟,郭 平,赵建飞,等.CH4、H,O在CaCO3(010) 表面吸附的第一性原理研究[J]. 原子与分子物理学报, 2019, 36(1): 165-172. QIN Juan, GUO Ping, ZHAO Jianfei, et al. First-Principles Calculation of Adsorption for Methane and Water on CaCO<sub>3</sub>(010) Surface[J]. Journal of Atomic and Molecular Physics, 2019, 36(1): 165-172.
- [28] 赵新新, 宓一鸣. Cu(001) 表面 CO 吸附单层结构和 电子态的第一性原理研究 [J]. 物理化学学报, 2008, 24(1): 127-132. ZHAO Xinxin, MI Yiming. First-Principle Calculations on the Atomic Geometry and Electronic States of CO Monolayer on Cu(001) Surface[J]. Acta Physico-Chimica Sinica, 2008, 24(1): 127-132.
- [29] 闪静祎, 王军凯, 黄珍霞, 等. 外电场对水在 CaO(100) 表面吸附的第一性原理计算 [J]. 耐火材料, 2021, 55(1): 44-50. SHAN Jingyi, WANG Junkai, HUANG Zhenxia, et al. First-Principle Calculation of Water Adsorption on CaO(100) Face Under External Electric Field[J]. Refractories, 2021, 55(1): 44-50.
- [30] 罗志坚, 张显苗, 胡纯蓉, 等. Ti-48Al-2Cr-2Nb 合金 高电位腐蚀行为 [J]. 包装学报, 2021, 13(1): 32-40. LUO Zhijian, ZHANG Xianmiao, HU Chunrong, et al. Corrosion Behavior of Ti-48Al-2Cr-2Nb Alloy with High Potential[J]. Packaging Journal, 2021, 13(1): 32-40.

(责任编辑: 李玉华)

(下转第60页)